

電子情報通信学会 研究会発表申込システム

研究会 開催プログラム

[\[ログイン\]](#)

(技報オンライン実施中)

通信ソサイエティのみ

[トップ](#) [戻る](#) [前のSDM研究会 /](#)
[\[HTML\]](#) / [\[HTML\(simple\)\]](#) / [\[TEXT\]](#)
[\[Japanese\]](#) / [\[English\]](#)

研究会終了後に懇親会を開催いたします。

シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 遠藤 哲郎 (東北大) 副委員長 奈良 安雄 (富士通セミコンダクター)

幹事 小野 行徳 (NTT), 野村 晋太郎 (筑波大)

幹事補佐 笹子 佳孝 (日立)

日時 2011年 7月 4日(月) 09:00 ~ 17:40

会場 名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー (〒464-8603 愛知県名古屋市千種区不老町・JR名古屋駅から名古屋市営地下鉄「名古屋大学」下車、3番出口から徒歩3分。

http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/access/index.html . 名古屋大学 大学院工学研究科 宮崎誠一 . 052-789-5447)

議題 ゲート絶縁薄膜、容量膜、機能膜およびメモリ技術(応用物理学会、シリコンテクノロジー分科会との合同開催)

7月4日(月) (09:00 ~ 17:40)

(1) 09:00 - 09:20

高温熱処理とMIPS構造によるLa-silicate/Si界面特性の改善と低EOTの実現

川那子高暢・角嶋邦之・パールハット アヘメト・筒井一生・西山 彰・杉井信之・名取研二・服部健雄・岩井 洋(東工大)

(2) 09:20 - 09:40

SiC(0001)面上エピタキシャルグラフェンの構造と形成

影島博之・日比野浩樹・山口浩司(NTT物性基礎研)・永瀬雅夫(徳島大)

(3) 09:40 - 10:00

Al₂O₃堆積膜をゲート絶縁膜に用いたSiC-MOSFETの作製と評価

山田泰之・石黒暁夫(東工大)・日野史郎・三浦成久(三菱電機)・徳光永輔(東工大)

(4) 10:00 - 10:20

Defect analysis of HfO₂/In_{0.53}Ga_{0.47}As interface using capacitance-voltage and conductance methods

Zade Darius・Hosoi Ryuji・Kakushima Kuniyuki・Ahmet Parhat・Tsutsui Kazuo・Nishiyama Akira・Sugii Nobuyuki・Natori Kenji・Hattori Takeo・Iwai Hiroshi(Tokyo Tech)

- - - 休憩 (20分) - - -

(5) 10:40 - 11:00

Si高指数面酸化過程のリアルタイム光電子分光による評価

大野真也・井上 慧・森本真弘・新江定憲・豊島弘明(横浜国大)・吉越章隆・寺岡有殿(原子力機構)・尾形祥一(横浜国大)・安田哲二(産総研)・田中正俊(横浜国大)

(6) 11:00 - 11:20

XPS時間依存測定法によるSiO₂/Si界面の電荷トラップ密度の面方位依存性の評価

石原由梨(芝浦工大)・渋谷寧浩・五十嵐 智(東京都市大)・小林大輔(宇宙研)・野平博司(東京都市大)・上野和良(芝浦工大)・廣瀬和之(宇宙研)

(7) 11:20 - 11:40

Siナノワイヤー、ナノレイヤの発光と界面

櫻井蓉子・大毛利 健・山田啓作(筑波大)・角嶋邦之・岩井 洋(東工大)・白石賢二・野村晋太郎(筑波大)

(8) 11:40 - 12:00

Evaluation of Light Induced Damages in Plasma Process on Electrical Properties of Al₂O₃/Ge Gate Stack Structure

Kusuman dari・Wakana Takeuchi・Kimihiko Kato・Shigehisa Shibayama・Mitsuo Sakashita・Osamu Nakatsuka・Shigeaki Zaima(Nagoya Univ.)

(9) 12:00 - 12:20

Ge(100)表面の極薄TiO_xキャッピングによるHfO₂原子層堆積/熱処理時の界面反応制御

村上秀樹・藤岡知宏・大田晃生・三嶋健斗・東 清一郎(広島大)・宮崎誠一(名古屋大)

- - - 昼食 (60分) - - -

(10) 13:20 - 13:40

Al₂O₃/Ge構造に対する酸素熱処理の界面特性に及ぼす効果
柴山茂久・加藤公彦・坂下満男・竹内和歌奈・中塚 理・財満鎮明(名大)

(11) 13:40 - 14:00

Pr酸化膜/Ge構造におけるPrの価数制御に基づく界面反応制御
加藤公彦・坂下満男・竹内和歌奈・中塚 理・財満鎮明(名大)

(12) 14:00 - 14:20

金属/GeO₂界面における化学結合状態の光電子分光分析
松井真史・藤岡知宏・大田晃生・村上秀樹・東 清一郎(広島大)・宮崎誠一(名大)

(13) 14:20 - 14:40

金属/Si界面の構造乱れによるショットキーバリア変調:第一原理計算による理論的検討
小日向恭祐・中山隆史(千葉大)

(14) 14:40 - 15:00

ハフニウム酸化物への元素添加効果 ~ 第一原理計算による検討 ~
中山利紀・川崎 裕・丸泉琢也(都市大)

(15) 15:00 - 15:20

ITO/HfO₂ MOSキャパシタで、酸化・還元熱処理がV_{fb}シフトへ及ぼす影響
生田目俊秀(物材)・山田博之(芝浦工大)・大井暁彦・知京豊裕(物材)・大石知司(芝浦工大)

- - - 休憩 (20分) - - -

(16) 15:40 - 16:00

高温熱処理によるTiN/Hf(La)SiOゲートスタック中Hf及びLa原子の拡散現象
大嶽祐輝・有村拓晃・佐伯雅之・力石薫介・北野尚武・細井卓治・志村考功・渡部平司(阪大)

(17) 16:00 - 16:20

Evaluation of electrical property at SrTiO₃ bicrystal interface by EBIC
Tetsuji Kato・ Son Phu Thanh Pham・Yoshiaki Nakamura・Jun Kikkawa・Akira Sakai(Osaka Univ.)

(18) 16:20 - 16:40

RFスパッタ形成したSi酸化膜を用いたMIMキャパシタの抵抗変化特性
大田晃生・後藤優太・西垣慎吾・Goubin Wei・村上秀樹・東 清一郎(広島大)・宮崎誠一(名大)

(19) 16:40 - 17:00

グリーンレーザーによる積層構造シリコン薄膜の同時結晶化と薄膜デバイスへの応用
堀田昌宏・山崎浩司・町田絵美・石河泰明・浦岡行治(奈良先端大)

(20) 17:00 - 17:20

相変化チャネルトランジスタを用いた積層型NOR PRAMの設計
加藤 翔・渡辺重佳(湘南工大)

(21) 17:20 - 17:40

低消費電力型デバイスを用いたシステムLSIの設計法
鈴木良輔・渡辺重佳(湘南工大)

一般講演:発表 15分 + 質疑応答 5分

応用物理学会、シリコンテクノロジー分科会共催

研究会終了後、懇親会を予定していますので御参加ください。

SDM研究会今後の予定 []内発表申込締切日

8月25日(木)~26日(金) (予定) 富山県民会館 [未定] テーマ:低電圧/低消費電力技術、新デバイス・回路とその応用

[問合せ先]

安齋 久浩(ソニー)

Tel 046-201-3297 Fax046-202-6572
E-mail: Hisahiro.Ansai@jp.sony.com

Last modified: 2011-04-15 17:53:10

ご注意: 迷惑メール対策のためメールアドレスの一部の文字を置換しております。ご了承ください。

[\[この開催に関する講演論文リストをダウンロードする\]](#) こちらのページの最下にあるダウンロードボタンを押してください

[\[研究会資料\(技術研究報告\)の当日価格一覧\]](#) 開催2週間前頃に掲載されます

[\[研究会発表・参加方法,FAQ\]](#) 一読ください

[\[SDM研究会のスケジュールに戻る\]](#) /

[トップ](#) [戻る](#) [前のSDM研究会](#) /

[\[HTML\]](#) / [\[HTML\(simple\)\]](#) / [\[TEXT\]](#)

[\[Japanese\]](#) / [\[English\]](#)

[\[研究会発表申込システムのトップページに戻る\]](#)

[\[電子情報通信学会ホームページ\]](#)

IEICE / 電子情報通信学会